Познакомьтесь с методами измерений малой мощности, малого напряжения и малого сопротивления

для измерения характеристик графена, углеродных нанотрубок и других наноматериалов и наноустройств

Роберт Грин (Robert Green) Keithley Instruments, Inc.



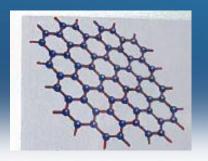


Содержание

- Свойства и применение графена
- Измерение характеристик материалов
- Приборы и методы для получения правильных результатов
- Измерение характеристик устройств
- Сложности на пути получения правильных результатов
- Заключение



Свойства графена



- Высококачественная, безупречная кристаллическая решетка без атомарных дефектов
- Прочные, но очень гибкие связи
 - Прочнее алмаза
 - Гибкость и способность выдерживать значительные деформации
- Очень высокая электро- и теплопроводность
 - Электроны свободно проходят сквозь графен и ведут себя в соответствии с квантовыми электродинамическими законами
 - Подвижность носителей ~10000 см²/(В*с) при комнатной температуре и до 200000 см²/(В*с) во взвешенном состоянии
- Прозрачность
- Сродство с другими элементами



Широкий диапазон возможных применений графена

Полупроводниковые транзисторы

Фотоэлектрические устройства

Прозрачные проводники

Датчики

Высокочастотные устройства

Эффективные солнечные элементы

Гибкие дисплеи

 NO_2

Сенсорные экраны

 NH_3

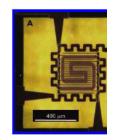
Печатная электроника

Динитротолуол

Одноэлектронные транзисторы

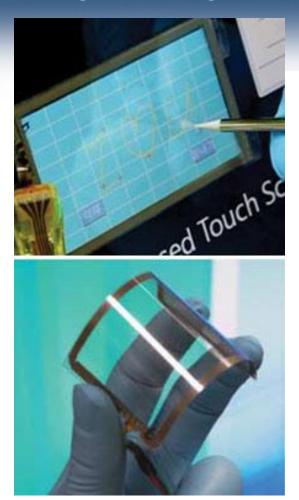


Полимерные композиты



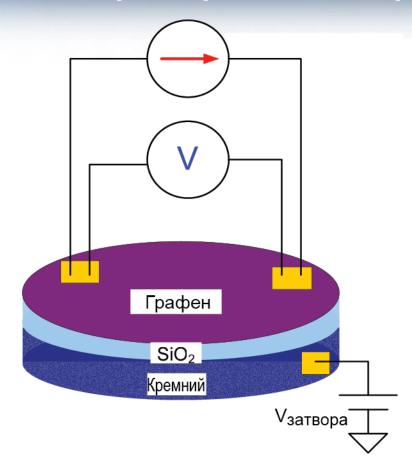


Гибкий сенсорный экран Samsung





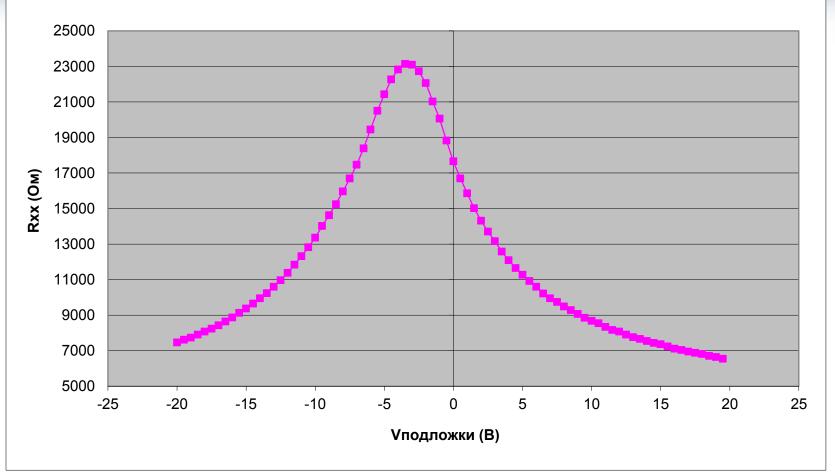
Измерение зависимости сопротивления от напряжения на затворе с применением методов измерения характеристик материалов





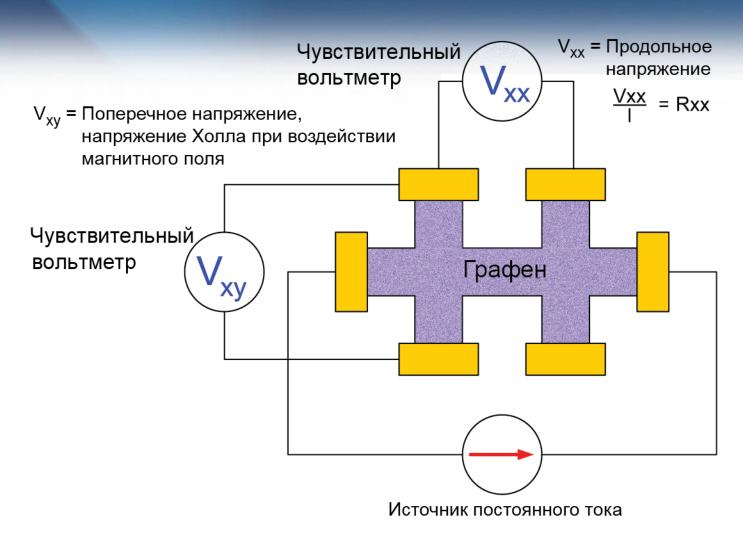
Результаты измерения графенового образца

Зависимость продольного сопротивления графенового слоя на кремниевой подложке от напряжения на подложке



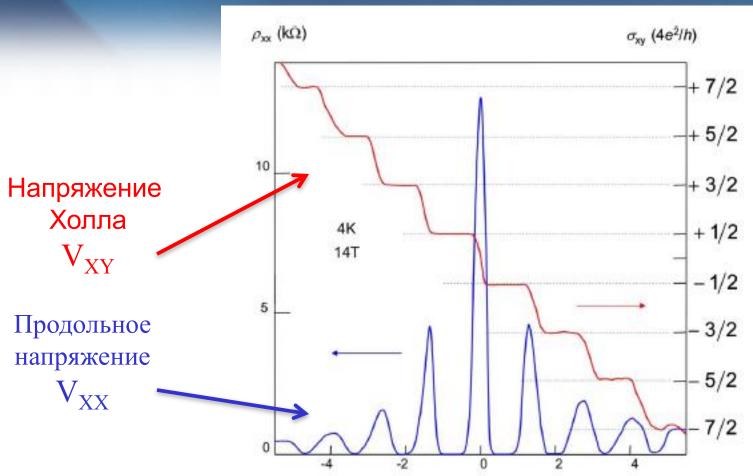


Метод измерения напряжения Холла и сопротивления





Пример измерения квантового эффекта Холла на графеновом образце



Источник: Кастро Нето с соавторами, Электронные свойства графена, журнал Reviews of Modern Physics, январь-март 2009.

n (1012 cm-2)



Рекомендуемые инструментальные опции Требования к источнику тока

Должен подавать очень малые токи (<<10⁻⁶A) с высокой точностью для ограничения мощности, рассеиваемой образцом

Должен обладать высоким коэффициентом стабилизации, гарантируя точное значение тока в материале

Должен допускать точную регулировку напряжения, во избежание перенапряжения и повреждения устройства

Должен быть биполярным, чтобы исключить смещение напряжения и снизить шум





Выходной ток: $100 \, \phi A - 100 \, \text{мA}$ Выходное сопротивление: $10^{14} \, \text{Ом}$

Точность установки: 0,1 В

Режимы работы: биполярный источник пост. тока, источник перем. тока (6221)



Рекомендуемые инструментальные опции Требования к нановольтметру

Должен точно измерять значения напряжения < мкВ

Должен обладать малым шумом

Высокое подавление шума переменного тока



Нановольтметр, модель 2182А



Разрешение: 1 нВ в диапазоне 10 мВ

Шум: $25 \text{ HB}_{\text{пик-пик}}$ при отклике 1 с

 $15 \ \mathrm{HB}_{\mathrm{пик-пик}}$ при отклике $25 \ \mathrm{c}$

Коэфф. подавления синфазных помех: 110 дБ



Рекомендуемые инструментальные опции Требования к источнику питания/измерителю

Интегрированный прецизионный источник и измеритель по 4-проводной схеме

Измеритель I

Источник V

V H

Измеритель V Источник I

Разрешение источника и чувствительность измерителя не хуже единиц мкА и мВ

Функция свипирования

Работа в четырех квадрантах

Встроенная компенсация смещения

Модель 2400 SourceMeter®



Разрешение источника: 50 пА, 5 мкВ

Чувствительность измерителя: 10 пА, 1 мкВ

Одно- и двухканальные модели



Рекомендуемые инструментальные опции Система для измерения параметров полупроводников

Готовый программно-аппаратный комплекс со встроенными процедурами измерения:

- Сопротивления
- Эффекта Холла
- Пост. напряжений и импульсных ВАХ
- ВФХ

Чувствительность измерителя тока до 100 аА, разрешение источника до 1,5 фА Модель 4225-РМU с Моделью 4225-RPM

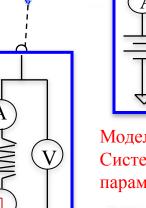
Разрешение источника напряжения 5 мкВ, чувствительность измерителя напряжения 1 мкВ

Удаленный предусилитель

50

Ом

Блок импульсных измерений



Источник питания/ измери-тель

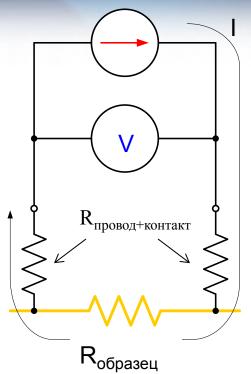
Модель 4200-SCS Система для измерения параметров п/п приборов



Зачем подавать ток и измерять напряжение по разным проводам?

Исключение ошибок, вызванных сопротивлением проводов и контактов

2-проводная схема



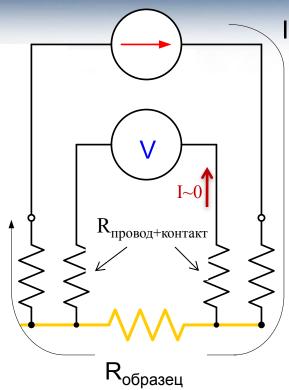
ОШИБКА

Расчетное сопротивление:

$$V_{M}/I = R_{\text{образец}}$$

- 2R_{провод+контакт}

4-проводная схема

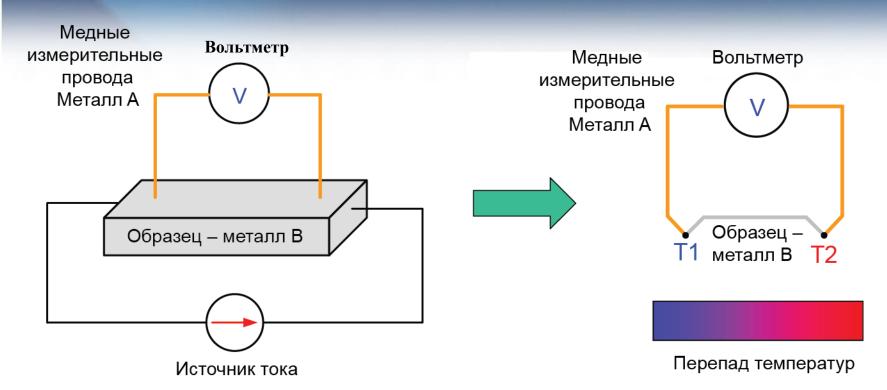


Расчетное сопротивление:

$$V_{M}/I = R_{\text{образец}}$$



Другой важный источник погрешности ТермоЭДС



ТермоЭДС генерируются в том случае, когда разнородные металлы в схеме (Металл A и Металл B) имеют разную температуру (Т1 и Т2).



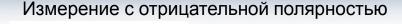
Способы уменьшения термоЭДС

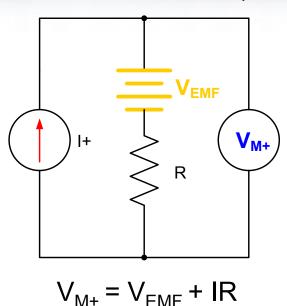
- При построении измерительной схемы используйте соединительные проводники из одинаковых материалов.
- Минимизируйте перепады температуры в пределах схемы.
- Дайте прогреться измерительному оборудованию.
- Используйте методы компенсации смещения.

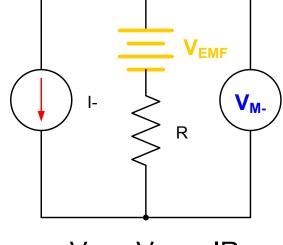


Применение метода обратного тока для компенсации напряжения смещения (V_{FMF})

Измерение с положительной полярностью







 $V_{M_{-}} = V_{FMF} - IR$

Расчет напряжения:

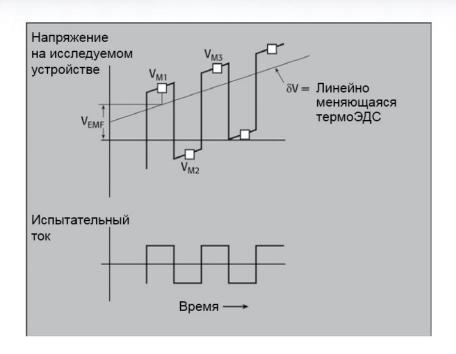
- V_{EMF} скомпенсировано

$$V_{Dif} = \frac{V_{M+} - V_{M-}}{2} = \frac{V_{EMF} + IR - (V_{EMF} - IR)}{2} = IR$$



Дальнейшие усовершенствования исключают и напряжение смещения и шум

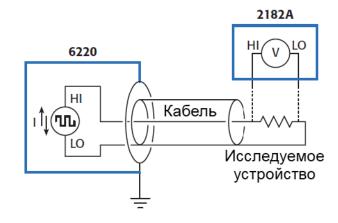
Режим дельта-измерений, реализованный в комбинации источника тока модели 6220 и нановольтметра 2182A



Усреднение сужает полосу шума и снижает низкочастотный шум

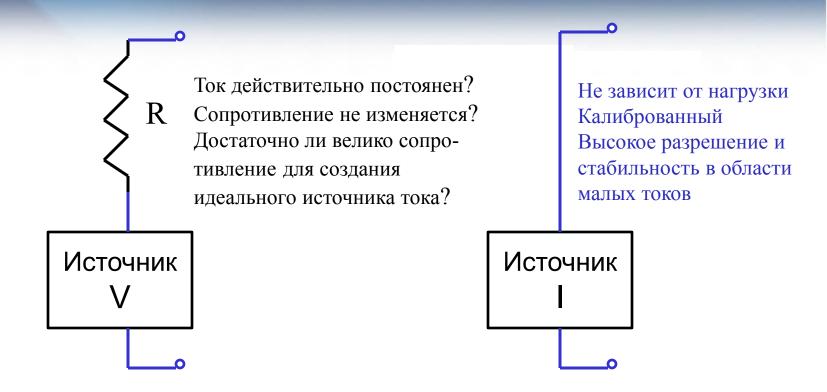
Дельта-метод

- 1. Источник тока переменной полярности
- 2. Получение скользящего среднего напряжения для расчета сопротивления



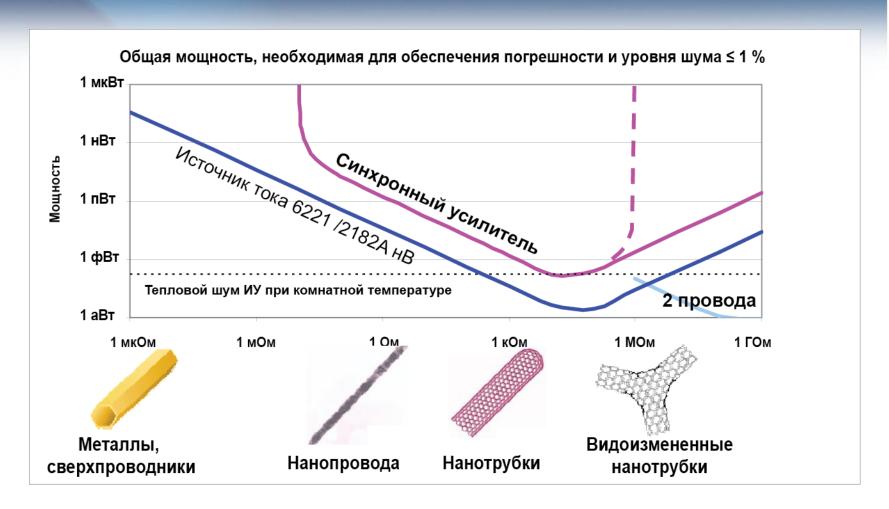


Пучше использовать источник тока, чем источник напряжения с последовательным сопротивлением





Модель 622X/2182A отвечает требованиям по малой рассеиваемой мощности и низкому уровню шума





Обеспечение надежного низкоомного контакта с графеном



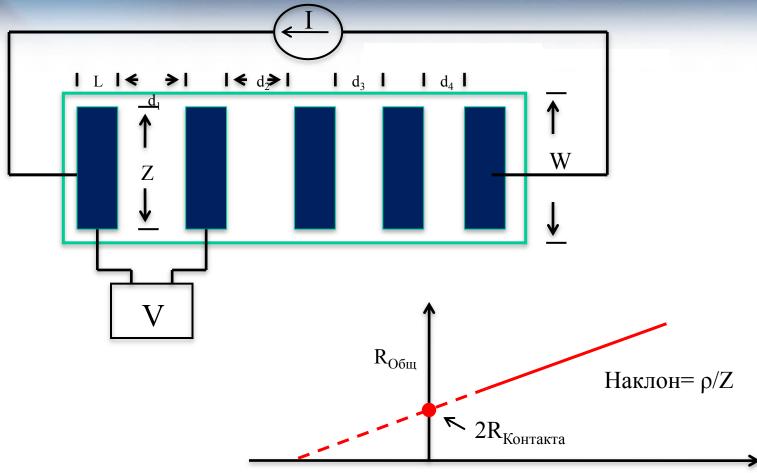
Достижимы сопротивления <10-7 Ом-см

Плазменная обработка в атмосфере O_2 перед металлизацией Отжиг в атмосфере N_2/H_2 при температуре 450° С - 475° С в течение 15 минут

> Источник: Установка контакта с графеном, Дж. Робинсон с соавторами, Государственный университет Пенсильвании, 2010



Определение сопротивления контактов путем измерения длины передачи

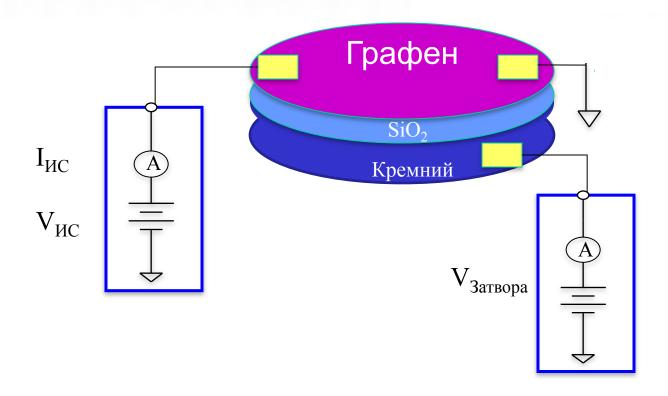


<u>Источник: Измерение параметров полупроводниковых приборов и материалов,</u> Дитер Шродер

Расстояние, d



Более удобное измерение структуры на основе графена Зависимость I_{ис} от V_{Затвора}





Измерение зависимости $I_{\text{ис}}$ от $V_{\text{затвора}}$ $V_{\text{ис}}$ = Константа

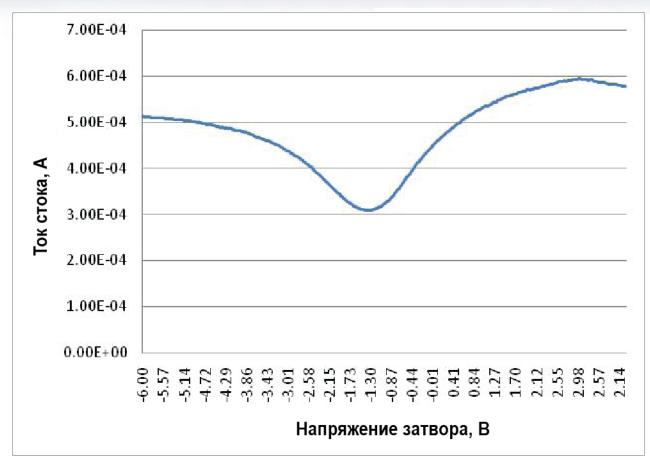
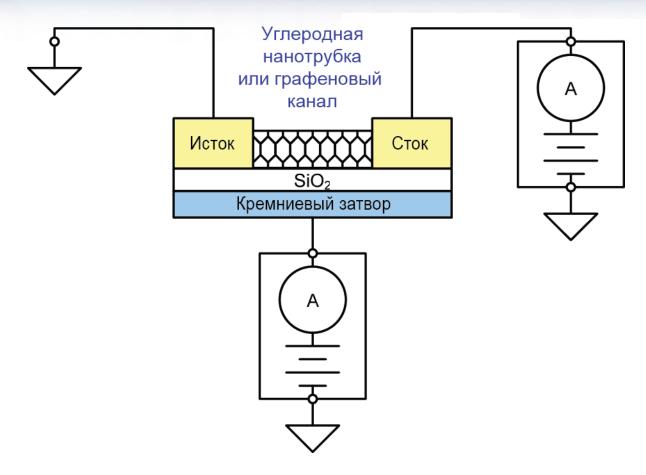




Схема измерения семейства ВАХ стока в полевом транзисторе на углеродной нанотрубке или в полевом транзисторе с графеновым каналом



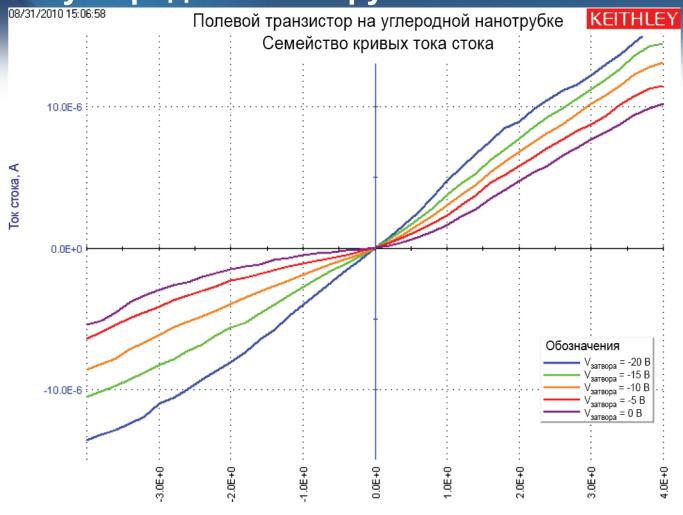


Пример измерения зависимости I_{ис} от V_{Затвора} для углеродной нанотрубки (CNT)





Пример измерения полевого транзистора на углеродной нанотрубке



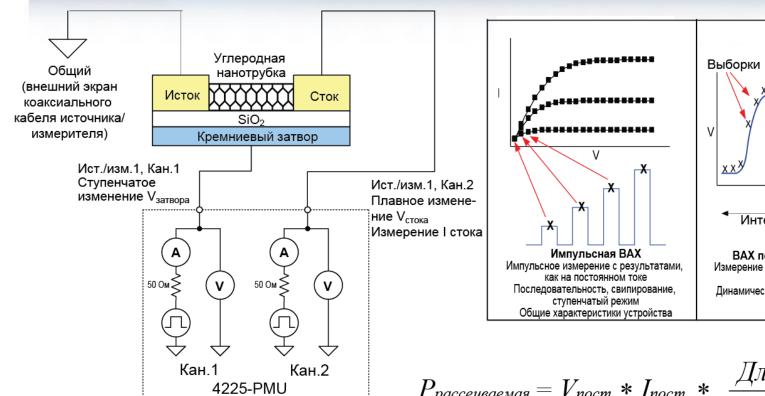
Напряжение затвора, В

ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ www.kelthley.com

KEITHLEY Измерение импульсной ВАХ полевого транзистора на углеродной нанотрубке

Пониженная рассеиваемая мощность и дрейф тока

Исследование быстрого отклика



xxxxxxxxxxXXXВремя Интервал измерения ВАХ переходного процесса Измерение зависимости I и V от времени Захват сигнала Динамическое тестирование устройства

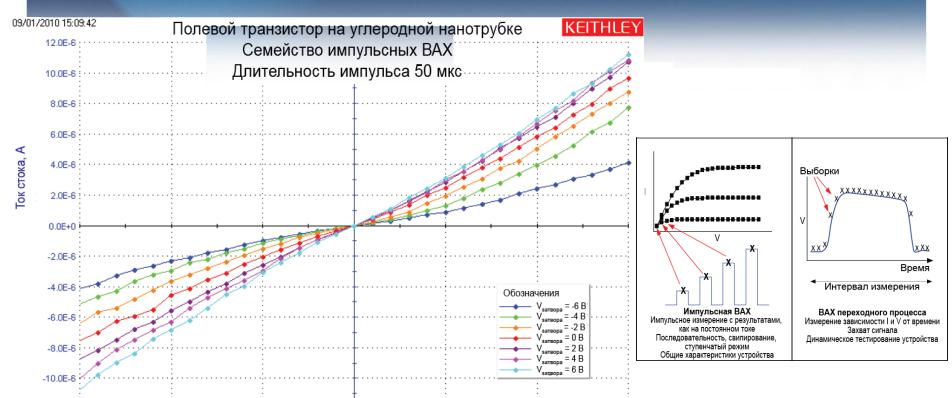
Pрассеиваемая =Vпост. *Iпост. *

Длит. импульса Период импульсов

Двухканальный блок импульсных измерений



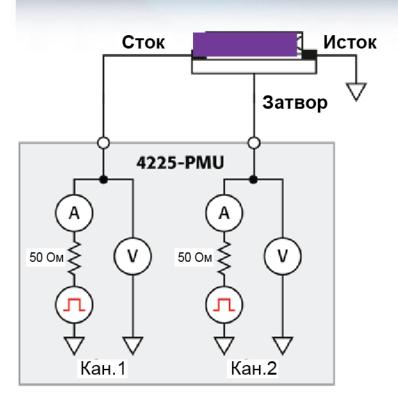
Импульсные ВАХ полевого транзистора на углеродной нанотрубке

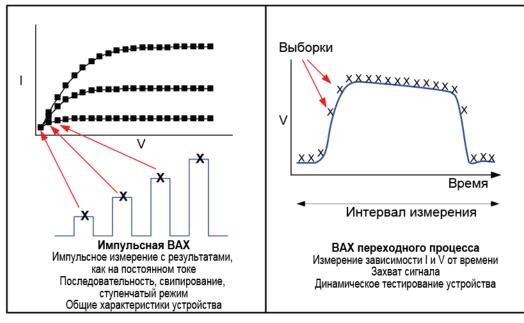


Импульсное напряжение затвора, В

KEITHLEY

Подача импульсного сигнала на графеновые устройства снижает ток дрейфа за счет захваченных зарядов и позволяет исследовать переходные процессы



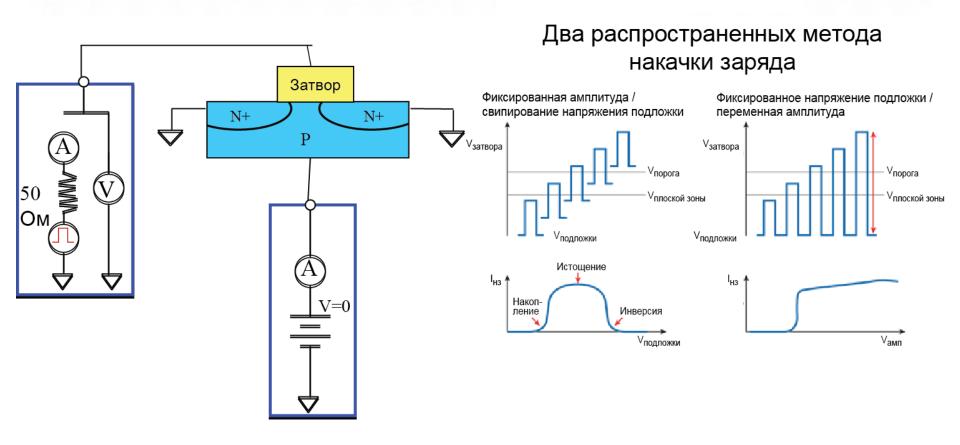


Двухканальный блок импульсных измерений



Измерение параметров канала – граница раздела диэлектрических сред Измерение накачки заряда

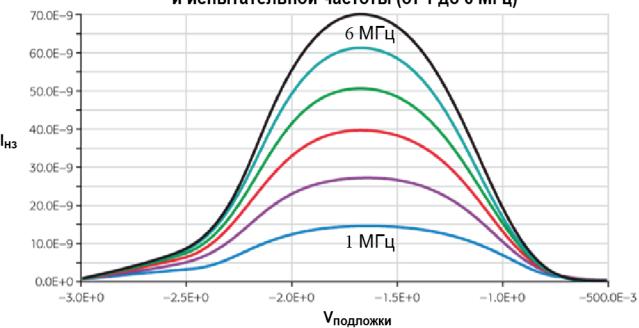
Схема измерения концентрации ловушек на границе раздела





Результаты измерения накачки заряда

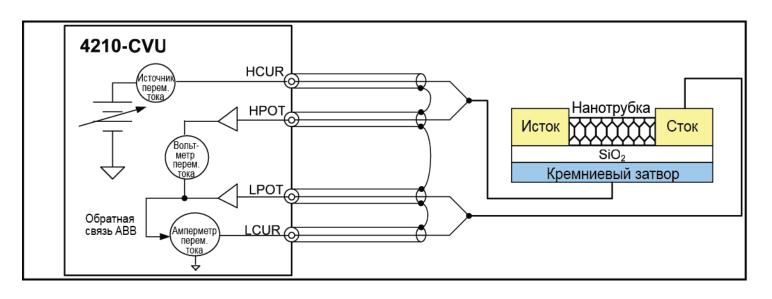
Зависимость тока накачки заряда (I_{нз}) от напряжения подложки (V) и испытательной частоты (от 1 до 6 МГц)

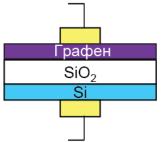




Измерение напряжения на конденсаторе

Сегодня можно изготавливать графеновые образцы достаточного размера для изучения оксидов в устройствах на основе графена



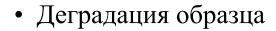




Источники ошибок при измерении характеристик материалов и устройств с малой рассеиваемой мощностью

- Неверный выбор приборов
- Сопротивление соединительных проводов
- Сопротивление контактов
- ТермоЭДС
- Источники шума
 - Низкочастотный шум
 - Внешние источники шума
 - Магнитные поля







Внешние источники шума

Люминесцентные лампы

Прочее электронное

оборудование



Электродвигатели насосов и др. приводы





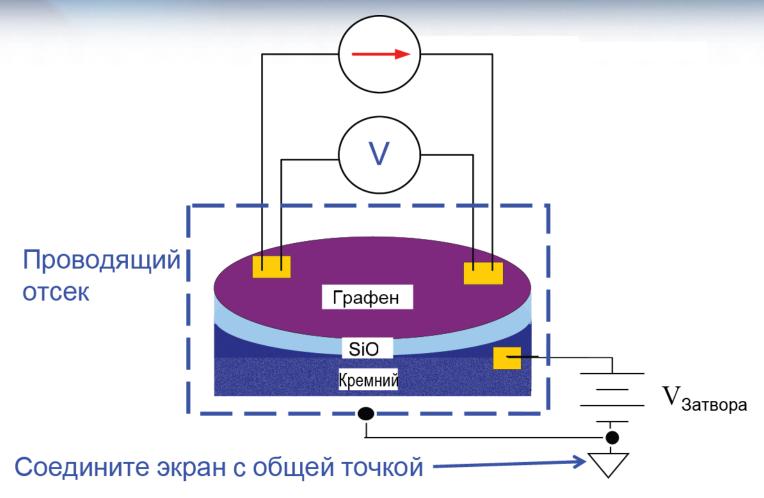
Радиопередающие устройства

Время

16,67 мс (60 Гц) 20 мс (50 Гц)



Размещение образца в электростатическом экране для минимизации помех от внешних источников





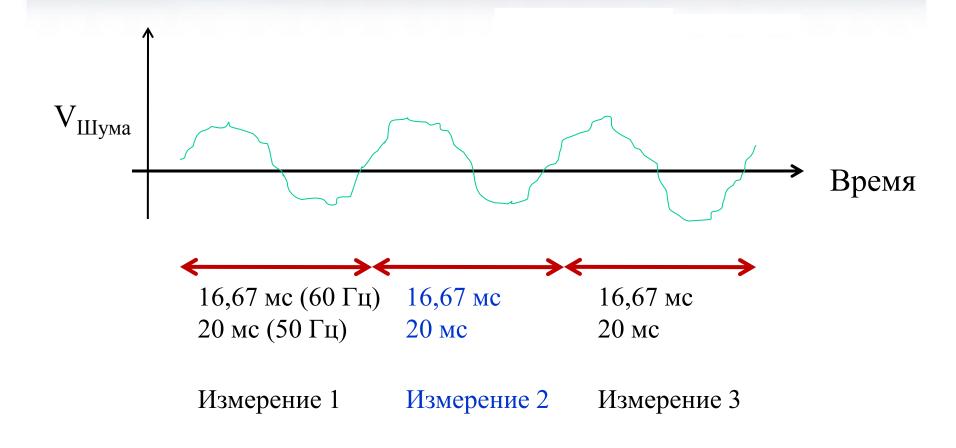
Повышение качества измерений за счет экранирования



www.kelthley.com

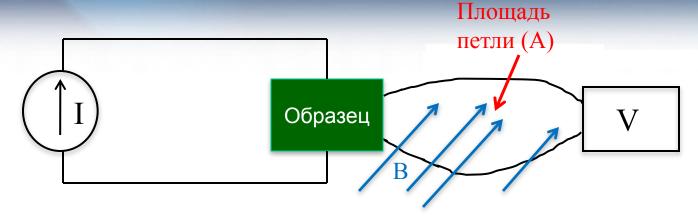


Повышение качества измерений Выполняйте измерение за период напряжения электросети

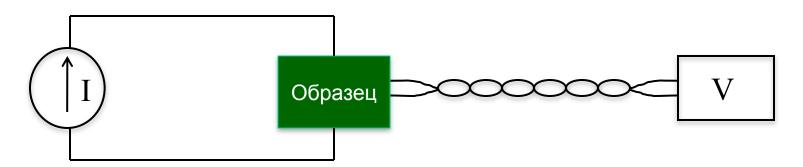




Исключайте напряжения, наведенные магнитными полями

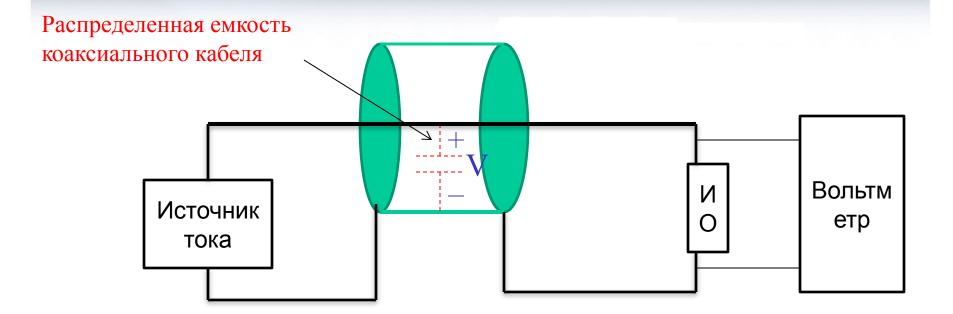


$$V_{B} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d(BA)}{dt} = B\frac{dA}{dt} + A\frac{dB}{dt}$$





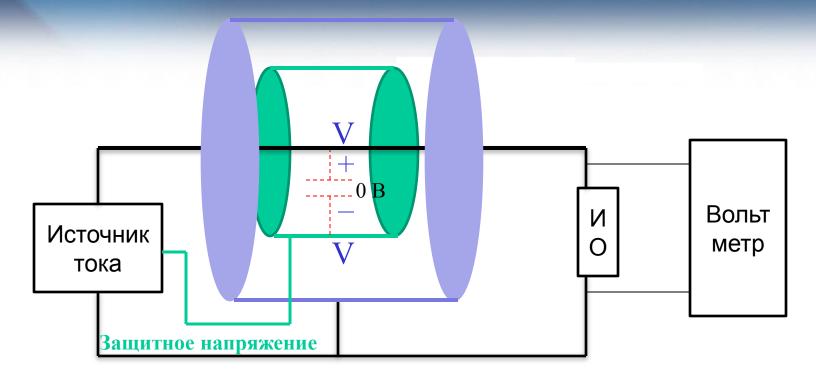
Напряжение на емкости кабеля может повредить маломощные образцы и тонкие проводники



При отключении источника тока емкость может разрядиться через испытуемый образец (ИО)



Триаксиальные кабели и защита могут снизить вероятность повреждения проводов и образца



Используйте 3-проводной триаксиальный кабель

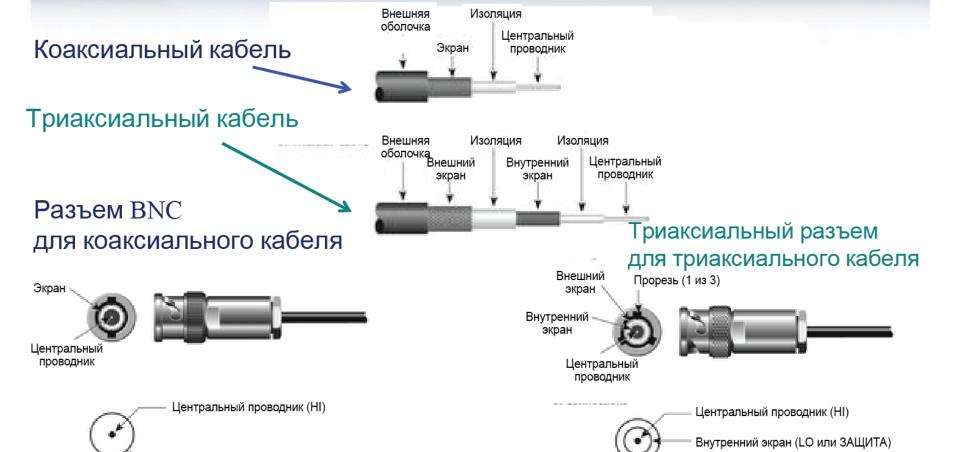
Подайте выходное напряжение на внутренний проводник

В этом случае ΔV между центральным и внутренним проводником = 0 В

Снижается вероятность разряда емкости кабеля через образец



Сравнение коаксиального кабеля с разъемом и триаксиального кабеля с разъемом

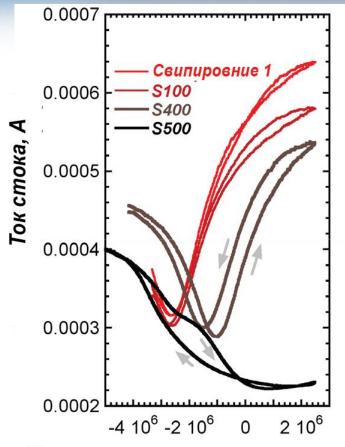


Экран (LO или земля)

Внешний экран (корпус или LO)



Проверяйте качество результатов своих измерений Не деградировал ли диэлектрик?



Напряженность электрического поля, В/см

Не снизился ли пиковый ток?

Не вырос ли гистерезис?



Заключение

Необходимо обеспечить следующие условия:

Приборы с достаточной чувствительностью и функциональностью

Надежные контакты измерительных цепей

Правильные методы измерения

Компенсация смещения

Интегрирование за период сетевого напряжения

Фильтрация

Экранирование

Исключение внешних источников шума

Минимизация рассеиваемой мощности



Дополнительные справочные материалы

- Справочник по измерениям для нанотехнологий
- Справочник по низкоуровневым измерениям

http://www.keithley.com/knowledgecenter

- «Измерение полупроводниковых приборов и материалов» Дитера Шродера
- Технические описания и рекомендации по применению для наших источников тока, нановольтметров, источников питания/измерителей и систем измерения характеристик полупроводниковых приборов можно найти на нашем сайте по адресу www.keithley.com.



Обращайтесь с вопросами в компанию Keithley

Головной офис В США: (+1) 888-КЕІТНLЕҮ За пределами США: (+1) 440-248-0400

Email: applications@keithley.com

Дополнительные офисы:

www.keithley.com

Россия и СНГ:

Официальный дистрибьтор ЗАО "НПП Эликс"

г. Москва, Каширское шоссе д.57 к.5

Email: eliks@eliks.ru

www.eliks.ru